

SOT223 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

FZT788B

ISSUE 3 - OCTOBER 1995

FEATURES

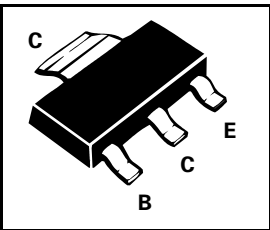
- * Low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)}$ **93mΩ at 3A**
- * Gain of 300 at $I_C=2$ Amps and Very low saturation voltage

APPLICATIONS

- * Battery powered circuits

COMPLEMENTARY TYPE – FZT688B

PARTMARKING DETAIL – FZT788B



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

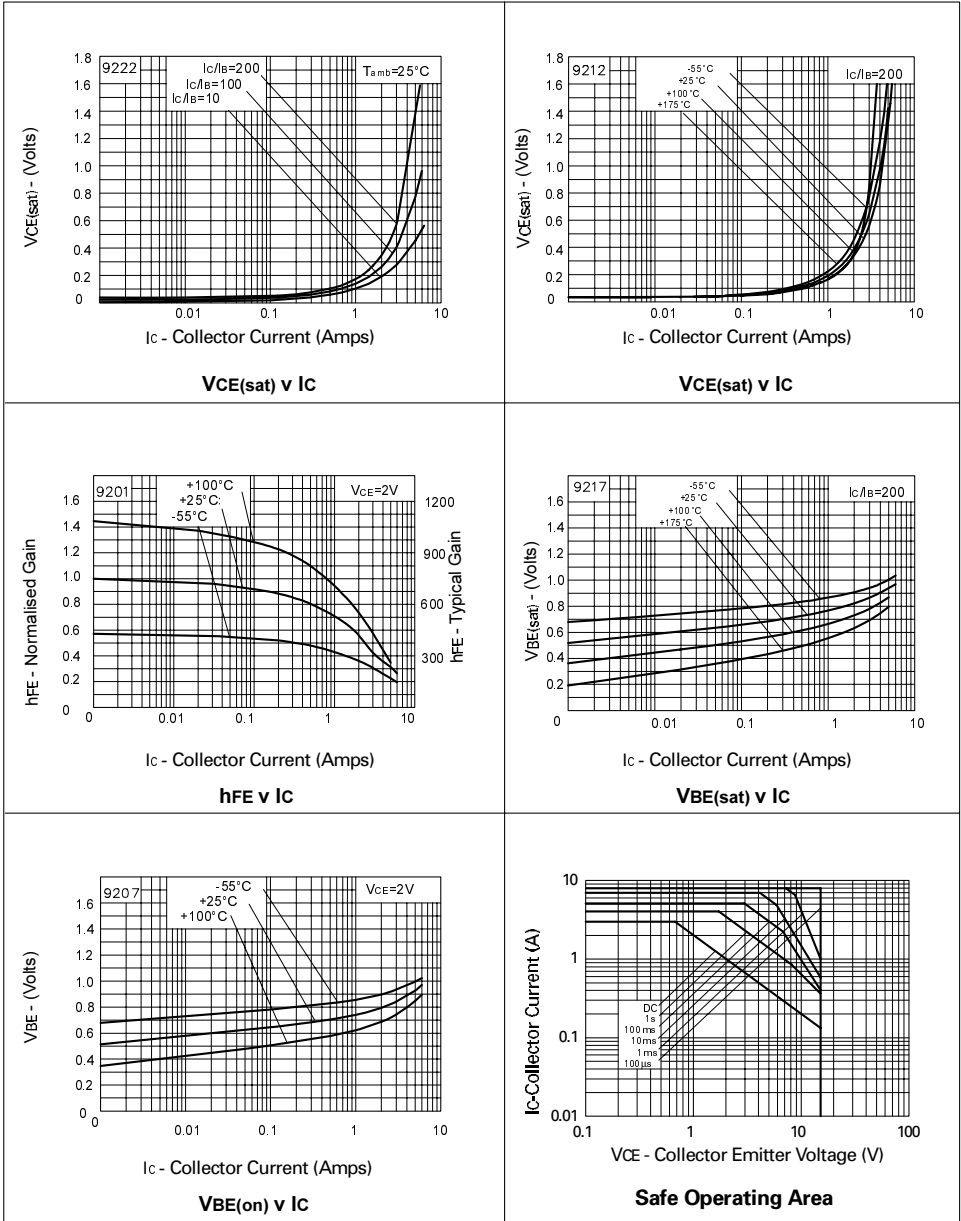
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-15	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-15	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-8	A
Continuous Collector Current	I_C	-3	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-15			V	$I_C=-100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-15			V	$I_C=-10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E=-100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-0.1	μA	$V_{CE}=-10V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-0.1	μA	$V_{EB}=-4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			-0.15 -0.25 -0.45 -0.5	V	$I_C=-0.5A, I_B=-2.5mA^*$ $I_C=-1A, I_B=-5mA^*$ $I_C=-2A, I_B=-10mA^*$ $I_C=-3A, I_B=-50mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			-0.9	V	$I_C=-1A, I_B=-5mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.75		V	$I_C=-1A, V_{CE}=-2V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	500 400 300 150		1500		$I_C=-10mA, V_{CE}=-2V^*$ $I_C=-1A, V_{CE}=-2V^*$ $I_C=-2A, V_{CE}=-2V^*$ $I_C=-6A, V_{CE}=-2V^*$
Transition Frequency	f_T	100			MHz	$I_C=-50mA, V_{CE}=-5V$ $f=50MHz$
Input Capacitance	C_{ibo}		225		pF	$V_{EB}=-0.5V, f=1MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		25		pF	$V_{CB}=-10V, f=1MHz$
Switching Times	t_{on} t_{off}		35 400		ns ns	$I_C=-500mA, I_{B1}=-50mA$ $I_{B2}=-50mA, V_{CC}=-10V$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%
Spice parameter data is available upon request for this device

TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.